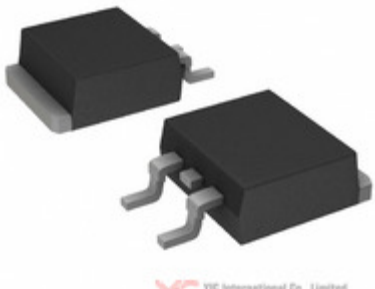
	<p><b>NSB8JT-E3/81</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NSB8JT-E3/81</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.NSB8JT-E3/81.pdf</a> <a href="#">2.NSB8JT-E3/81.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 260 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	NSB8JT-E3/81
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	260 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz

NSB8JT-E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8JT-E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8JT-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8JT-E3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSB8JT-E3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8JT-E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8JT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8GT-E3_A/P</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>
 <p><b>NSB8JT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8JT-E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8JT-E3/45</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p><b>NSB8GT-E3_A/P</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 8A TO263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8JT-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	NSB8JT-E3/81-Datenblätter	NSB8JT-E3/81 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division NSB8JT-E3/81
NSB8JT-E3/81 Electronic	NSB8JT-E3/81-Komponenten	NSB8JT-E3/81-Bild	NSB8JT-E3/81-Teil
NSB8JT-E3/81 Preis	NSB8JT-E3/81 Hersteller	NSB8JT-E3/81 Bild	NSB8JT-E3/81 Inventar
NSB8JT-E3/81 Neu	NSB8JT-E3/81 Original	NSB8JT-E3/81 garantiert	NSB8JT-E3/81 RFQ
			NSB8JT-E3/81 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited